**Алимов, Владимир Хасатович.**

## Закономерности накопления ионно-имплантированного гелия в поверхностных слоях никеля : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 02.00.04. - Москва, 1984. - 169 с. : ил.

## Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Алимов, Владимир Хасатович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕЛИЯ С РАДЗЩЭДОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

В МЕТАЛЛАХ.

§1.1. Процессы дефектообразования в металлах при облучении ионами гелия.

§ 1.2. Диффузия гелия в металле. Взаимодействие атомов гелия с дефектами вакансионного типа

§ 1.3. Зарождение и рост гелиевых пузырьков при температурах менее 0,3ThJ,

§ 1.4. Накопление и ре эмиссия гелия в металлах.

§ 1.5. Влияние облучения примесными ионами на поведение ионно-имплантированного гелия.

Постановка задачи.

ГЛАВА П. МЕТОД ПОСЛОЙНОГО АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В

МЕТАЛЛЕ.